

# 愛普科技股份有限公司

## 法人說明會

2018.03.29  
凱基證券12F

# 免責聲明

簡報中所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性。任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況，本簡報資料中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。



# 報告大綱

- 引言
- 財務資訊
- 營運狀況
- 未來展望

# 引言

- 去年 NAND 缺貨，影響 LPDRAM 業績
- 堅持公司定位，持續禮聘專才
- 深化與晶圓代工廠之合作
- 創造現有產品線之新契機
- 推出新產品

# 財務資訊

# 2017年度合併損益表

inNT\$K	2017年度	2016年度	ΔAMT	Δ%
營業收入	4,236,815	3,161,932	1,074,883	34%
營業成本	3,197,799	2,221,686	976,113	44%
營業毛利	1,039,016	940,246	98,770	11%
毛利率(%)	24%	30%	6%	(20%)
鎖售費用	120,505	52,119	68,386	131%
管理費用	99,677	82,608	17,069	21%
研發費用	386,325	281,139	105,186	37%
營業費用小計	606,507	415,866	190,641	46%
營業淨利	432,509	524,380	(91,871)	(18%)
營業淨利率(%)	10%	17%	(7%)	(38%)
業外收支小計	(114,708)	(18,868)	(95,840)	508%
本期淨利(損)	236,389	386,897	(150,508)	(39%)
淨利率(%)	5%	12%	(7%)	(54%)
歸屬於本公司淨利(損)	251,315	404,909	(153,595)	(38%)
每股盈餘(NT\$)	3.58	6.07	(2.49)	(41%)

# 2017年合併資產負債表

inNT\$K	2017.12.31		2016.12.31		ΔAMT	Δ%
	AMT	%	AMT	%		
現金及約當現金、貨幣基金及3個月以上定存等	1,066,354	33%	1,480,690	38%	(414,336)	(28%)
應收帳款淨額	598,575	18%	1,090,771	28%	(492,196)	(45%)
存貨淨額	942,274	29%	652,932	17%	289,342	44%
待出售流動資產	46,109	1%	-	-	46,109	-
其他流動資產	109,487	4%	94,084	3%	15,403	16%
採用權益法之投資	74,303	2%	75,465	2%	(1,162)	(2%)
不動產、廠房及設備	68,341	2%	80,507	2%	(12,166)	(15%)
商譽	76,204	3%	76,290	2%	(86)	0%
其他無形資產	102,502	3%	113,638	3%	(11,136)	(10%)
其他	159,604	5%	189,733	5%	(30,129)	(16%)
資產總計	3,243,753	100%	3,854,110	100%	(610,357)	(16%)
長、短期借款	100,000	3%	280,066	8%	(180,066)	(64%)
應付帳款	385,981	13%	442,372	11%	(56,391)	(13%)
其他應付款)	101,840	3%	144,562	4%	(42,722)	(30%)
本期所得稅負債	47,649	1%	55,183	1%	(7,534)	(14%)
其他	10,941	-	26,483	1%	(15,542)	(59%)
負債總計	646,411	20%	948,666	25%	(302,255)	(32%)
普通股股本	709,293	22%	704,503	18%	4,790	1%
資本公積總計	826,272	25%	792,513	21%	33,759	4%
保留盈餘	1,085,893	34%	1,071,407	28%	14,486	1%
其他	(24,116)	(1%)	(21,837)	(1%)	(2,279)	10%
本公司業主權益	2,597,342	80%	2,546,586	66%	50,756	2%
非控制權益	-	-	358,858	9%	(358,858)	(100%)
權益總計	2,597,342	80%	2,905,444	75%	(308,102)	(11%)

# 2017年度現金流量情形

In NT\$K

## 營業活動之現金流量

營運產生之現金

收取之利息

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入(出)

2017年

2016年

556,637

492,381

7,395

5,213

(3,234)

-

(104,794)

(98,769)

456,004

398,825

## 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入(出)

(10,808)

(77,967)

## 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入(出)

(755,828)

297,302

匯率變動對現金及約當現金之影響

(3,695)

(6,544)

現金及約當現金淨(減少)增加

(314,327)

611,616

年初現金及約當現金餘額

1,376,210

764,594

年底現金及約當現金餘額

1,061,883

1,376,210



# 2017 年財務結構

	2017	2016
流動比率	427.29%	355.92%
速動比率	267.63%	280.43%
平均收現天數	74天	119天
存貨周轉天數	108天	81天
純益率	5.58%	12.24%
資產報酬率	6.73%	13.11%

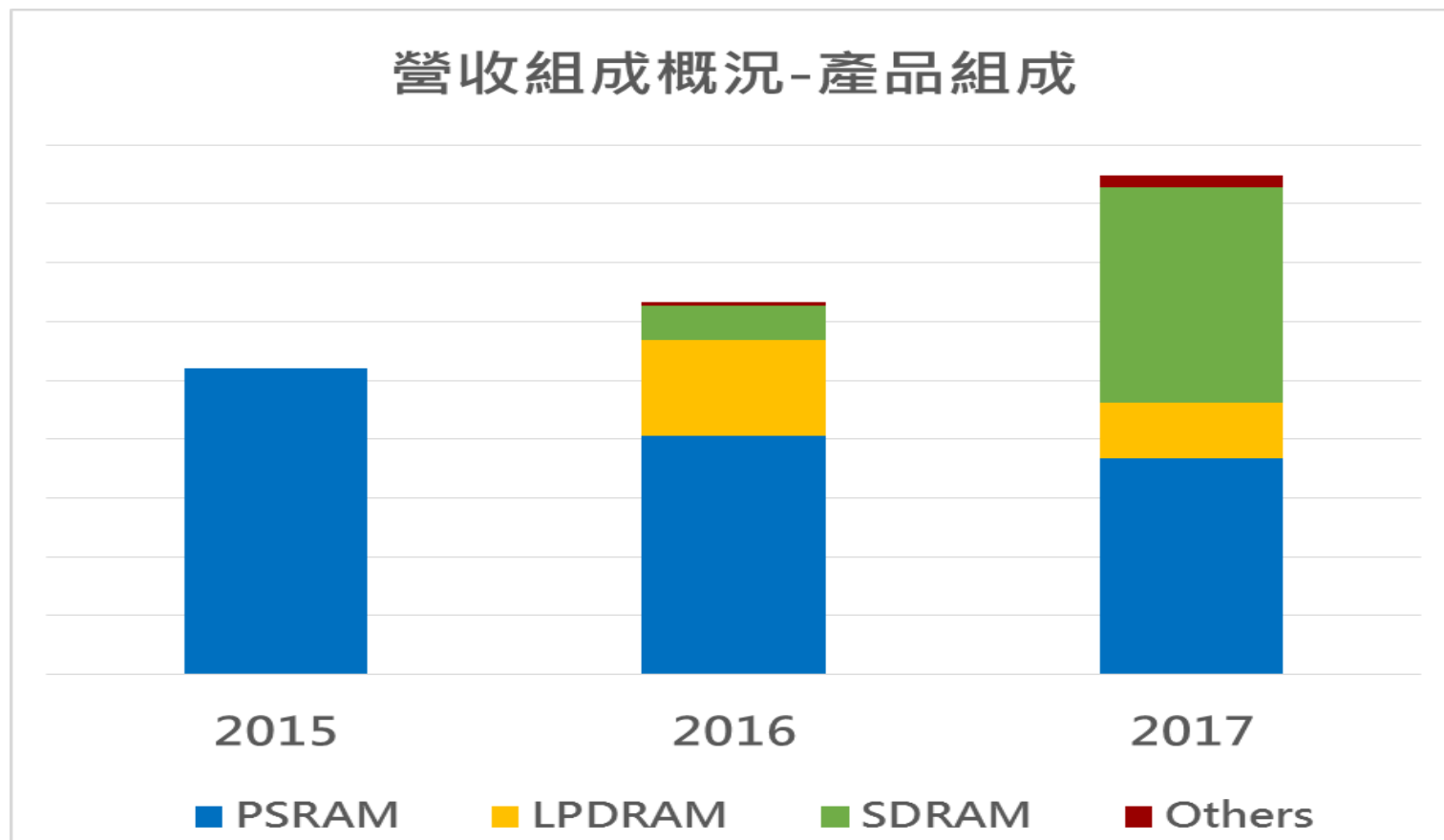
# 營運狀況

# 營運狀況

	2015	2016	2017
營收	2,602,510	3,161,932	<b>4,236,815</b>
毛利率	36%	30%	<b>24%</b>
營業淨利	517,211	524,380	<b>432,509</b>

\*係合併財務資訊，力積電子自2016.11起計入之

# 營收組成概況-產品組成



\*係合併財務資訊，力積電子自2016.11起計入之

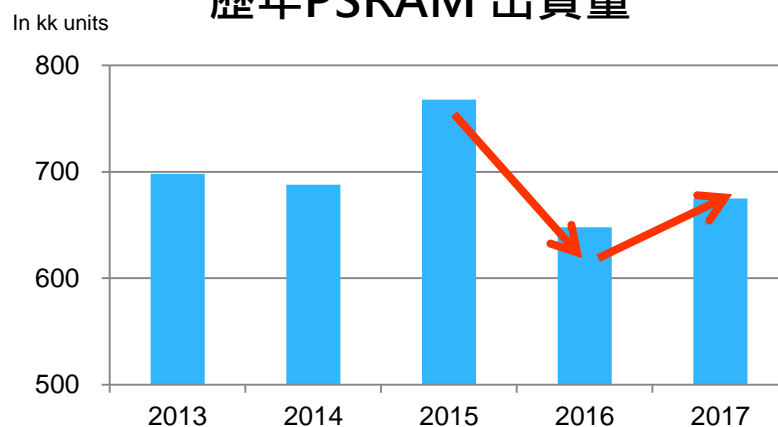
# 目前主要產品線

- 差異化記憶體產品線
  - PSRAM 為主
- 利基型標準記憶體產品線
  - SDRAM 為主
- 中高容量行動記憶體產品線
  - LPDRAM 為主

# 差異化記憶體產品線

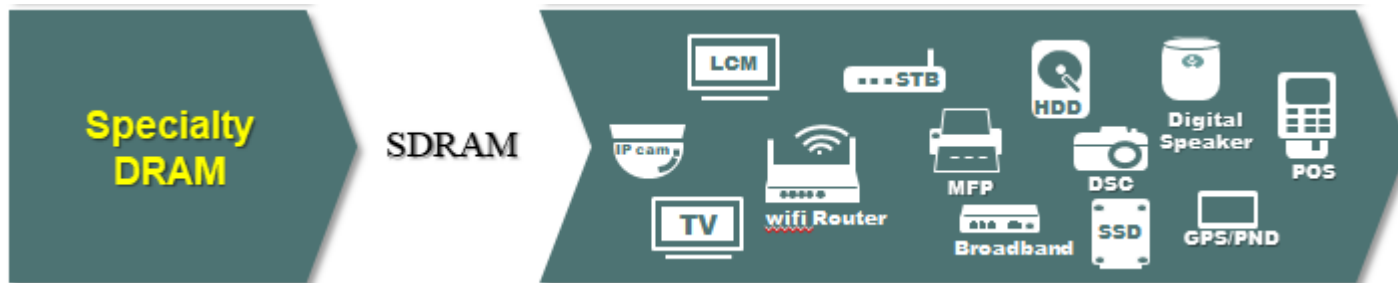
- PSRAM為主
  - MCU記憶體的最佳選擇
  - IoT應用持續擴大
  - 持續開發新應用市場

歷年PSRAM 出貨量



# 利基型標準記憶體產品線

- SDRAM為主
  - 配合多樣化的MPU應用
  - 提高一線客戶市場滲透率
  - 聚焦於工業控制、自動化系統之應用市場



# 中高容量行動記憶體產品線

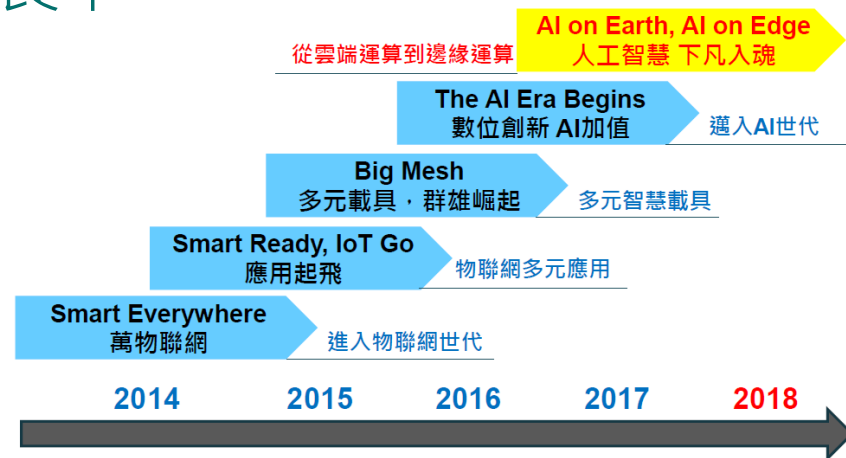
- LPDRAM為主
  - 行動記憶體產品線佈局完整
  - 全面支持行動裝置之記憶體需求
  - 低階LTE手機市場客戶需求強勁



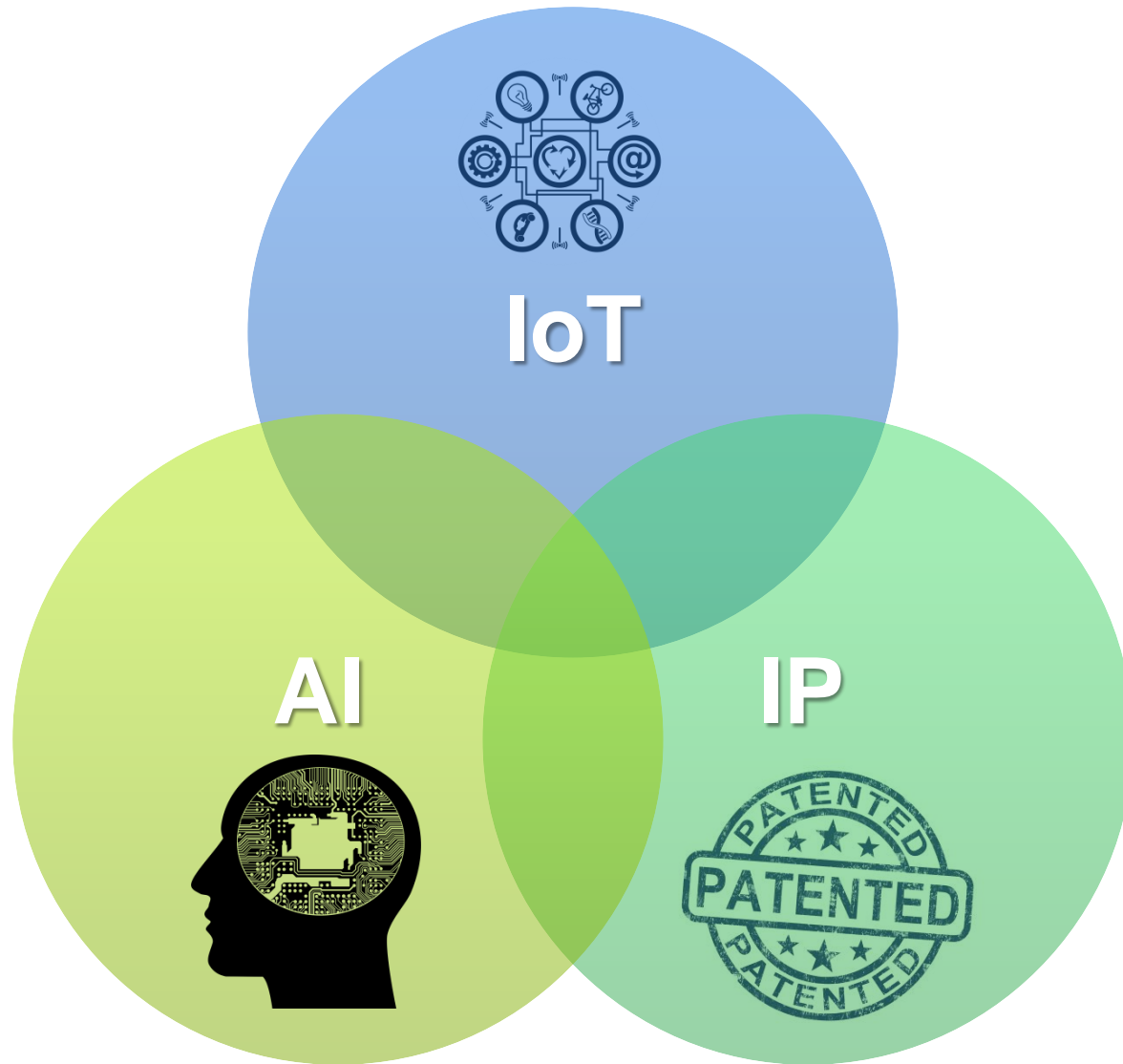


# 中長期營運重點

- 彈性調配產品組合
  - 著重毛利相對較高之產品
  - 聚焦產品價值而非價格
- 深耕現有產品佈局
  - 技術：SiP for 2Gb and below
  - 成本：持續提升產品良率
- 擴展未來應用市場
  - IoT多元應用
  - 佈局Edge AI

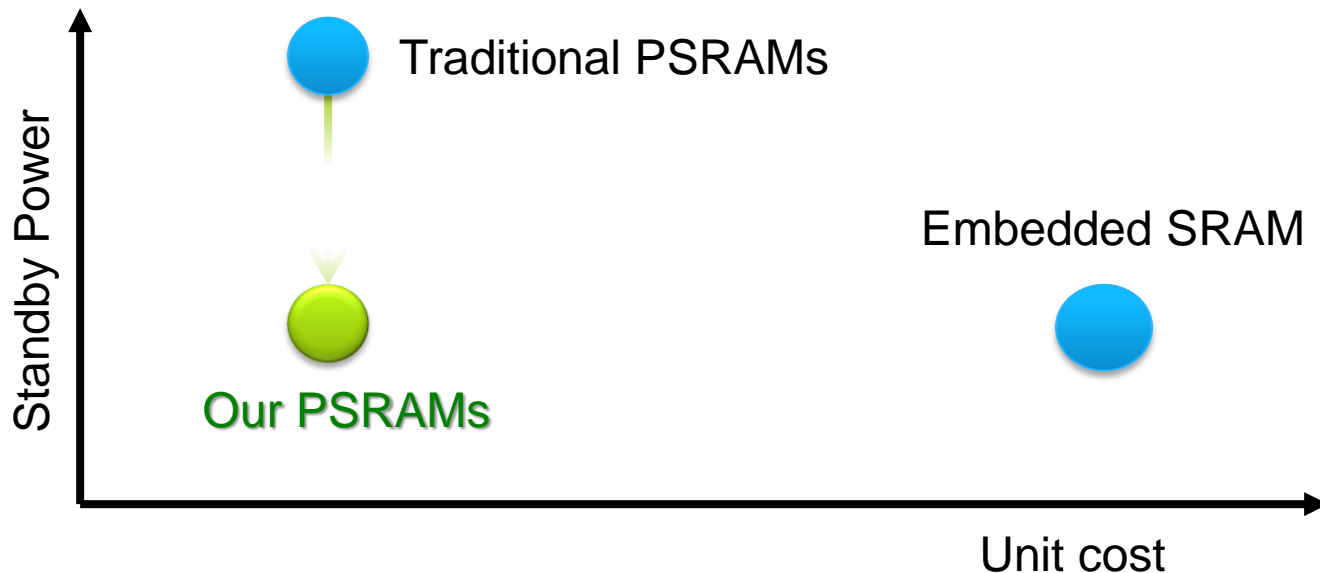


# 未來展望

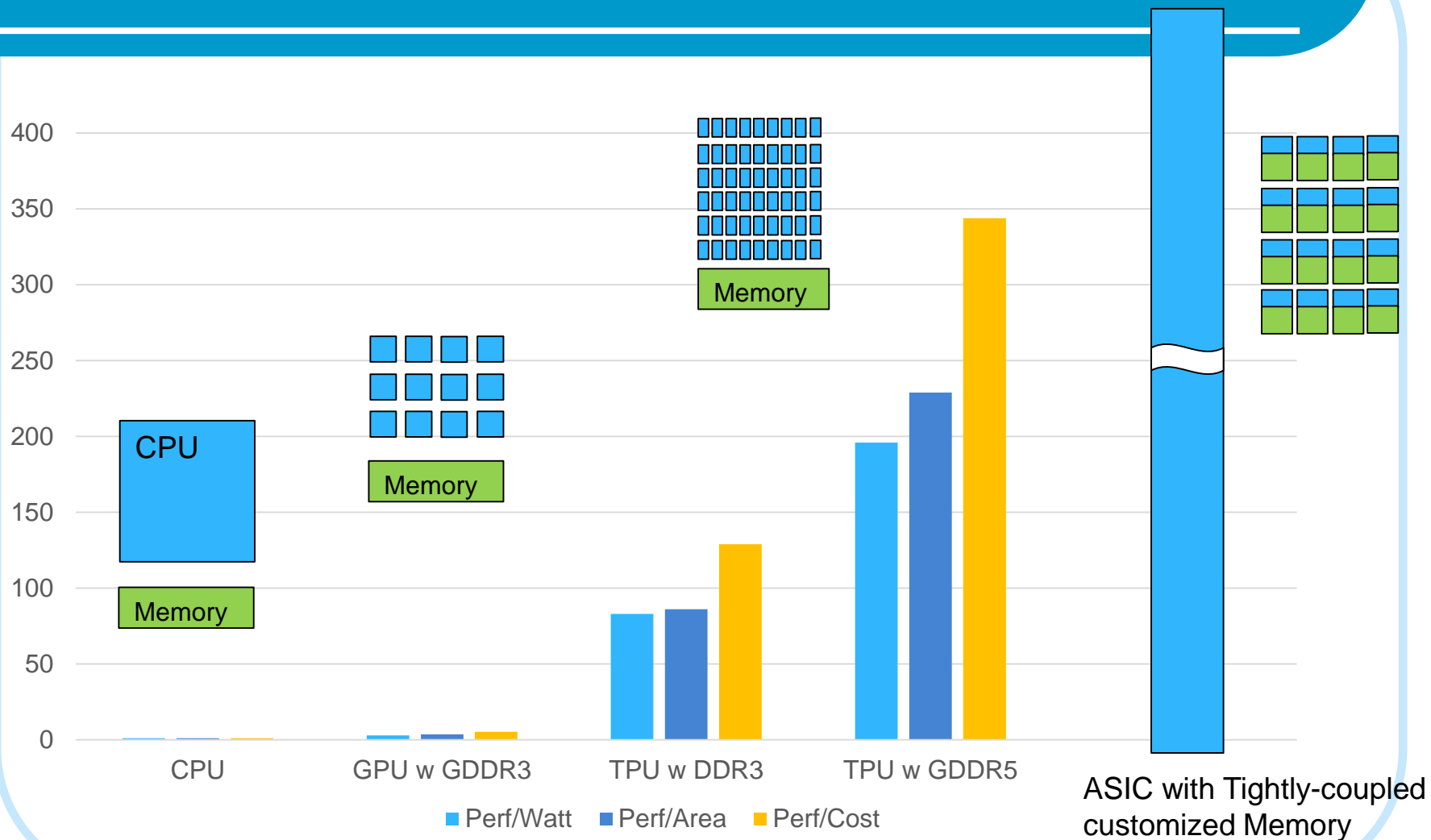


# IoT is here 物聯網已成現實

- Our position in IoT: best memory partner
  - Lowest power
  - Lowest cost
  - **Volume shipping now!**
- Example: NB-IoT

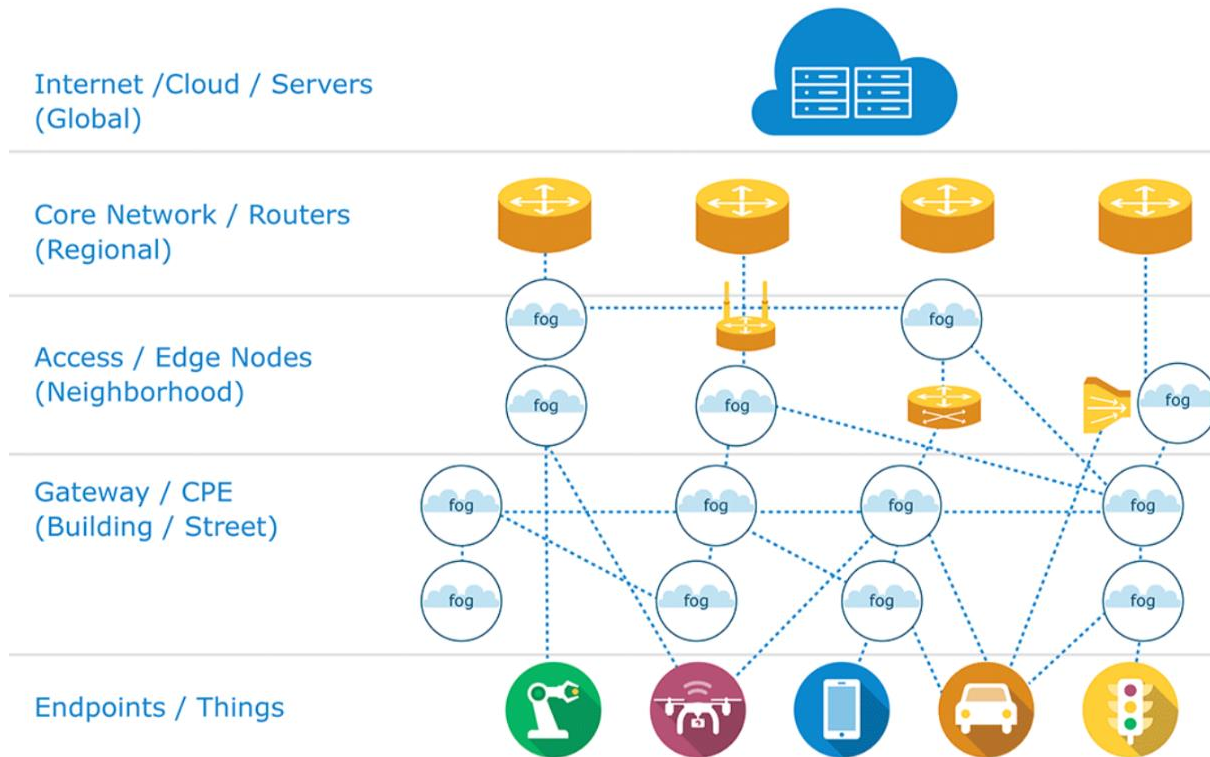


# Memory is bottleneck for AI



Source: Google, Bernstein Research, AP Memory Research

# AI+IoT=Edge Computing



IOT & AI meet at Edge Computing  
We are positioning our memory for it.

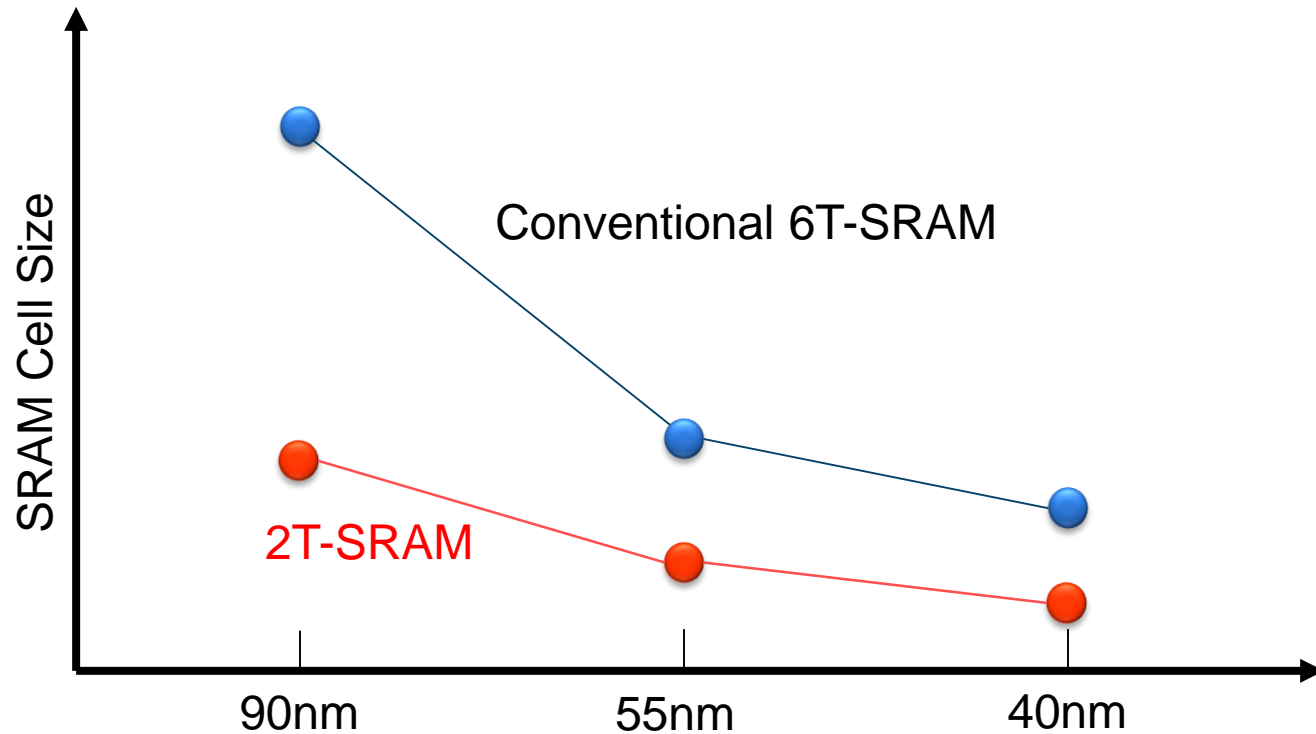
Picture source: <https://mse238blog.stanford.edu/2017/07/rentschc/data-at-the-edge-but-what-does-it-mean/>

# IP for the future

- Ongoing long-range memory architecture research
- Disclosing two IP projects today
  - 2T-SRAM for OLED Display Driver
  - Ferroelectric Memory for 3D Cross-Point Memory

# 2T-SRAM for OLED Driver

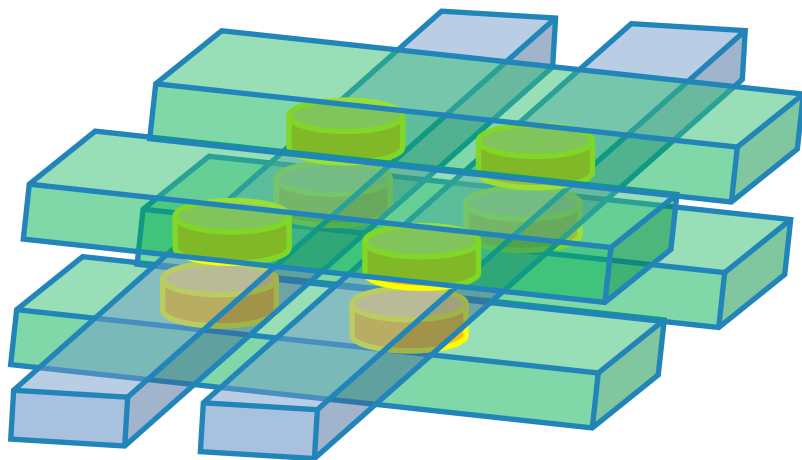
- ~3X smaller than 6T-SRAM





# Ferroelectric Memory Architecture

- 3D Cross-Point Memory





## Q & A

發言人信箱：[ir@apmemory.com](mailto:ir@apmemory.com)

發言人專線：(03)5601651